

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年4月16日(2015.4.16)

【公開番号】特開2013-182942(P2013-182942A)

【公開日】平成25年9月12日(2013.9.12)

【年通号数】公開・登録公報2013-049

【出願番号】特願2012-44300(P2012-44300)

【国際特許分類】

H 01 L 21/027 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/30 5 1 4 A

【手続補正書】

【提出日】平成27年3月2日(2015.3.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

境界線で互いに接する第1領域および第2領域を有する半導体装置の製造方法であって、

前記境界線に平行で前記第1領域の中に配置された第1線と前記境界線に平行で前記第2領域の中に配置された第2線とで幅が規定された境界線上ライン部を含むパターンを形成するフォトリソグラフィー工程を含み、前記フォトリソグラフィー工程は、

基板に塗布されたフォトレジストに対して、前記第1線を規定するための第1露光および前記第2線を規定するための第2露光を別個に実施する露光工程と、

前記露光工程を経た前記フォトレジストを現像する工程と、を含む、

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項2】

前記第1露光において、前記第1領域の中に前記境界線上ライン部に平行な複数の第1ライン部を規定するように前記フォトレジストを露光し、

前記第2露光において、前記第2領域の中に前記境界線上ライン部に平行な複数の第2ライン部を規定するように前記フォトレジストを露光する、

ことを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項3】

前記複数の第1ライン部における隣り合う第1ライン部の間隔、前記複数の第1ライン部のうち前記境界線上ライン部に最も近い第1ライン部と前記境界線上ライン部との間隔、前記複数の第2ライン部における隣り合う第2ライン部の間隔、および、前記複数の第2ライン部のうち前記境界線上ライン部に最も近い第2ライン部と前記境界線上ライン部との間隔が、互いに等しい、

ことを特徴とする請求項2に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項4】

前記境界線は、所定方向に沿った直線に平行な複数の直線部と、前記複数の直線部を連結する連結部とを含み、

前記半導体装置は、複数の前記境界線上ライン部を有し、前記複数の直線部のそれぞれに対して1つの前記境界線上ライン部が設けられている、

ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の半導体装置の製造方法。

**【請求項 5】**

前記フォトレジストは、ポジ型フォトレジストである、  
ことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法。

**【請求項 6】**

前記フォトレジストは、ネガ型フォトレジストである、  
ことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法。